



薄膜芯片电容

性能特点

- 现货供应，明码标价。
- 采用 MM 结构，产品寄生参数小，使用频率高至 100GHz。
- 表面纯金电极，适合金丝、金带等微组装工艺。
- 适合 Au/Sn、Au/Si、Au/Ge 共晶焊，以及 Sn /Pb、导电胶粘接。
- 质量等级为工业级。

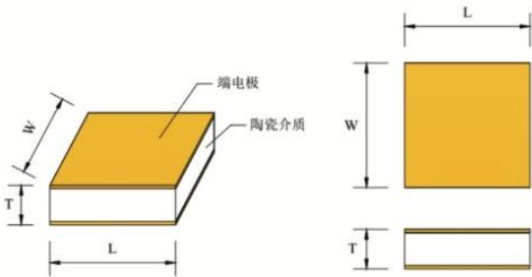


产品应用

用于航天、航空、雷达、电子对抗、微波毫米波通讯及光纤通讯中的 T/R 组件及其模块，主要起隔直、旁路、滤波、调谐、匹配等用途。

外形尺寸

外形尺寸 单位: mm		
L	W	T
0.254±0.076	0.254±0.076	0.178±0.050
0.381±0.127	0.381±0.127	0.178±0.050
0.508±0.127	0.508±0.127	0.178±0.050
0.635±0.127	0.635±0.127	0.178±0.050
0.762±0.127	0.762±0.127	0.178±0.050
0.889±0.127	0.889±0.127	0.178±0.050
1.012±0.127	1.012±0.127	0.178±0.050
2.290±0.254	2.290±0.254	0.178±0.050



常用型号及参数

序号	型号	容值	容差	温度范围	耐压 (V)	封装尺寸 (mm)
1	0.254*0.254*0.178-4.7P	4.7P	±0.5P	-55~+125℃	100V	0.254*0.254*0.178
2	0.254*0.254*0.178-8.2P	8.2P	±0.5P	-55~+125℃	100V	0.254*0.254*0.178
3	0.381*0.381*0.178-22P	22P	±20%	-55~+125℃	50V	0.381*0.381*0.178

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。

4	0.635*0.635*0.178-68P	68P	±20%	-55~+125℃	100V	0.635*0.635*0.178
5	0.381*0.381*0.178-100P	100P	±20%	-55~+125℃	50V	0.381*0.381*0.178
6	0.762*0.762*0.178-100P	100P	±20%	-55~+125℃	100V	0.762*0.762*0.178
7	0.762*0.762*0.178-1000P	1000P	±20%	-55~+125℃	50V	0.762*0.762*0.178